

Presseinformation

Infineon stellt neue Generation von Reverse Conducting IGBTs vor – optimiert für Anwendungen im Bereich Induktionskochen

Neubiberg – 24. Februar 2014 – Die Infineon Technologies AG komplettiert das Angebot an RC (Reverse Conducting)-IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) für resonante Applikationen mit der Einführung eines 1350-V-Bausteins mit monolithisch integrierter 20 A RC-Diode. Die neuen 20 A RC-H5-Bausteine unterstreichen die Leistungsführerschaft der RC-H-Familie und zielen insbesondere auf optimierte Systemeffizienz und die hohen Ansprüche in Anwendungen für [Induktionskochfelder](#) und Mikrowellenherde.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration reduziert der RC-H5 die Schaltverluste nochmals um 30 Prozent. Damit können Entwickler die Vorteile von höheren Frequenzen bis zu 30 kHz nutzen. So kann mit einem RC-H5-Baustein der Wirkungsgrad des Gesamtsystems ohne zusätzlichen Schaltungsaufwand um 0,5% auf jetzt 92 Prozent gesteigert werden. Durch den möglichen Einsatz von kleineren Induktoren mit weniger Kupfer werden zudem die Systemkosten gesenkt. Der diskrete RC-H5-IGBT basiert auf der bahnbrechenden Technologie des RC-H3, die weiterhin für bestehende Designs zur Verfügung steht.

Durch die Reduktion der Leistungsaufnahme und die Verbesserung des thermischen Verhaltens bei höheren Umgebungstemperaturen bis zu 175 °C konnte die Zuverlässigkeit des RC-H5 weiter erhöht werden. Der Baustein zeichnet sich durch einen um 10 Prozent reduzierten Einschalt-Spitzenstrom aus, was zu weniger Stress für die passiven Komponenten führt und die Systemzuverlässigkeit erhöht. Ein verbessertes elektromagnetisches Störverhalten (EMI) ist ein weiterer Vorteil. Das hat geringere Anforderungen an den Eingangsfiler zur Folge, was mit reduzierten Kosten für den Entwickler einhergeht.

„Mit der neuesten Generation der diskreten RC-H5-Bausteine unterstreicht Infineon seine führende Stellung in der IGBT-Technologie und adressiert die hohen Anforderungen bei Anwendungen im Bereich des Induktionskochens“, sagt Roland Stele, Marketing Director IGBT Power Discretes bei Infineon Technologies. „Ein-

mal mehr konnten wir die Grenzen des Wirkungsgrades und der Zuverlässigkeit eines Gesamtsystems mit applikationsspezifisch optimierten Leistungsschaltern für unsere Kunden erweitern. Dafür nutzen wir unsere tiefgehende technologische Expertise und unser weitreichendes Systemverständnis für Hausgeräte-Anwendungen.“

Portfolio und Verfügbarkeit

Die RC-H5-Familie steht in der Stromklasse von 20 A und mit Sperrspannungen von 1200 V und 1350 V in TO-247-Gehäusen zur Verfügung. Der RC-H5 1350 V/20 A wird bereits geliefert, während der RC-H5 1200 V/20 A im 2. Quartal 2014 erhältlich sein wird. Die weitere Verfügbarkeit der leistungsfähigen RC-H3-Familie bleibt von der Ankündigung der neuen RC-IGBT-Generation unberührt.

Weitere Informationen über die RC-H5-Familie von Infineon sind erhältlich unter: www.infineon.com/rch5.

Über Infineon

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: [Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse.